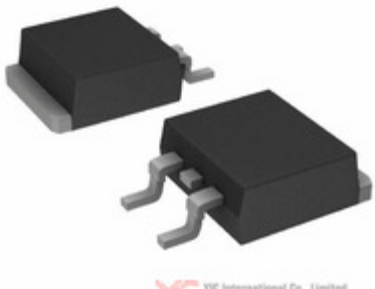
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB049NE7N3GATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 80A TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB049NE7N3GATMA1.pdf</p>
<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB049NE7N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 80A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.8V @ 91µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.9 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB049NE7N3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4750pF @ 37.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 80A (Tc) 150W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB049NE7N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB049NE7N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB049NE7N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB049NE7N3GATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB04N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A D2PAK</p>	 <p>IPB049NE7N3G INF IPB049NE7N3G INF</p>	 <p>IPB04CNE8NG VB IPB04CNE8NG VB</p>	 <p>IPB049NE7N3 G Infineon Technologies IPB049NE7N3 G Infineon Technologies</p>
 <p>IPB049N06L3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB04CN10NG INFINEON IPB04CN10NG INFINEON</p>	 <p>IPB049N08N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V TO263-3</p>	 <p>IPB04N03LA G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A TO-263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB049NE7N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB049NE7N3GATMA1 Datenblatt	IPB049NE7N3GATMA1-Datenblätter	IPB049NE7N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB049NE7N3GATMA1
IPB049NE7N3GATMA1 Electronic	IPB049NE7N3GATMA1-Komponenten	IPB049NE7N3GATMA1-Verteiler	IPB049NE7N3GATMA1-Bild	IPB049NE7N3GATMA1-Teil
IPB049NE7N3GATMA1 Preis	IPB049NE7N3GATMA1 Hersteller	IPB049NE7N3GATMA1 Bild	IPB049NE7N3GATMA1 Aktie	IPB049NE7N3GATMA1 Inventar
IPB049NE7N3GATMA1 Neu	IPB049NE7N3GATMA1 Original	IPB049NE7N3GATMA1 garantiert	IPB049NE7N3GATMA1 RFQ	IPB049NE7N3GATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited